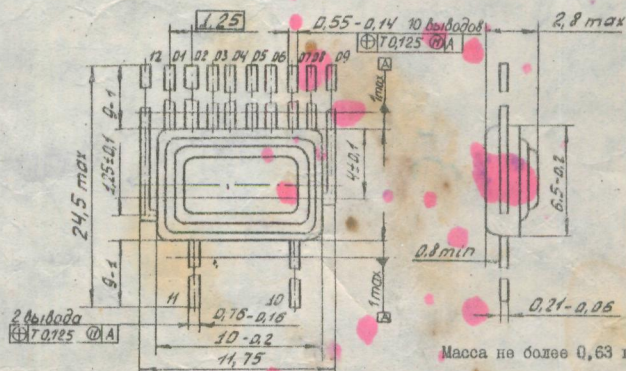




ДИОДНАЯ МАТРИЦА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ 2Д917А0С

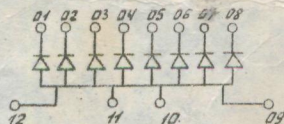
ЭТИКЕТКА

Кремниевая эпитаксиально-планарная импульсная диодная матрица полупроводниковая (ДМП) 2Д917А0С в металлостеклянном корпусе, предназначенная для работы в аппаратуре специального назначения.



Масса не более 0,63 г

Схема соединения электродов с выводами



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Постоянный обратный ток при $U_{обр} = 50$ В, мкА	$I_{обр}$	0,87	5,0
Постоянное прямое напряжение при $I_{пр} = 200$ мА, В	$U_{пр}$		1,17
Время обратного восстановления диода при $U_{обр,u} = 10$ В, $I_{пр} = 200$ мА, $I_{обр,гсч} = 3$ мА, $R_z = 1$ кОм, нс	$t_{обр,гсч}$		50
Общая емкость диода ДМП при $U_{обр} = 0$, пФ	C_d		6,0
Общая емкость всех диодов ДМП при $U_{обр} = 0$, пФ	C_z		40

670